#### JAPAN PATENT OFFICE

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this office.

Date of Application:

January 28, 2003

Application Number:

Japanese Patent Application

No. 2003-018777 [JP2003-018777]

Applicant(s):

FUJITSU MEDIA DEVICES LIMITED

January 19, 2004

Commissioner,

Japan Patent Office

Yasuo Imai (Seal)

Certificate No. 2003-3112298



#### 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

C ...

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 1月28日

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2003-018777

[ST. 10/C]:

[JP2003-018777]

出 願
Applicant(s):

富士通メディアデバイス株式会社

2004年 1月19日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井原



【書類名】

特許願

【整理番号】

02121801

【提出日】

平成15年 1月28日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

H03H 9/25

【発明の名称】

弾性表面波デバイス及びその製造方法

【請求項の数】

23

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番12号 富士通

メディアデバイス株式会社内

【氏名】

三島 直之

【特許出願人】

【識別番号】

398067270

【氏名又は名称】

富士通メディアデバイス株式会社

【代理人】

【識別番号】

100087480

【弁理士】

【氏名又は名称】 片山 修平

【電話番号】

043-351-2361

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

153948

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0117701

要

【プルーフの要否】



#### 【書類名】 明細書

【発明の名称】 弾性表面波デバイス及びその製造方法

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電基板上に形成された弾性表面波フィルタ素子と、前記弾性表面波フィルタ素子を収納するパッケージとを有する弾性表面波デバイスにおいて、

前記弾性表面波フィルタ素子は電気信号を入出力するためのバンプを有し、 前記パッケージは前記弾性表面波フィルタ素子が搭載される第1の基板を有し

前記第1の基板は前記バンプを介して前記弾性表面波フィルタ素子と電気的に 接続するための基板配線を有し、

前記第1の基板は100μm以下の厚みを有して構成されていることを特徴と する弾性表面波デバイス。

【請求項2】 前記パッケージにおける前記弾性表面波フィルタ素子を収納するキャビティの内壁であって該弾性表面波フィルタ素子の前記バンプ形成面と 反対側に対応する面に電気シールドを有することを特徴とする請求項1記載の弾性表面波デバイス。

【請求項3】 前記第1の基板の裏面に前記弾性表面波フィルタ素子へ電気的に接続された電気端子を有し、

前記電気端子が前記パッケージの長辺に沿って配設されていることを特徴とする請求項1又は2記載の弾性表面波デバイス。

【請求項4】 前記第1の基板の裏面に前記弾性表面波フィルタ素子へ電気的に接続された電気端子を有し、

前記電気端子が前記パッケージの短辺に沿って配設されていることを特徴とする請求項1又は2記載の弾性表面波デバイス。

【請求項5】 前記第1の基板における前記弾性表面波フィルタ素子と反対側の面に第2の基板を有し、

前記第2の基板は、少なくとも前記弾性表面波フィルタ素子直下の領域に空隙 を有することを特徴とする請求項1又は2記載の弾性表面波デバイス。



【請求項6】 前記第1の基板における前記弾性表面波フィルタ素子と反対側の面であって前記空隙内部に電気シールドを有することを特徴とする請求項5 記載の弾性表面波デバイス。

【請求項7】 前記第2の基板の裏面に前記弾性表面波フィルタ素子へ電気的に接続された電気端子を有し、

前記電気端子が前記パッケージの長辺に沿って配設されていることを特徴とする請求項5又は6記載の弾性表面波デバイス。

【請求項8】 前記第2の基板の裏面に前記弾性表面波フィルタ素子へ電気的に接続された電気端子を有し、

前記電気端子が前記パッケージの短辺に沿って配設されていることを特徴とする請求項5又は6記載の弾性表面波デバイス。

【請求項9】 前記第2の基板における前記第1の基板と反対側の面に第3の基板を有することを特徴とする請求項5又は6記載の弾性表面波デバイス。

【請求項10】 前記第3の基板の裏面に前記弾性表面波フィルタ素子へ電気的に接続された電気端子を有し、

前記電気端子が前記パッケージの長辺に沿って配設されていることを特徴とする請求項9記載の弾性表面波デバイス。

【請求項11】 前記第3の基板の裏面に前記弾性表面波フィルタ素子へ電気的に接続された電気端子を有し、

前記電気端子が前記パッケージの短辺に沿って配設されていることを特徴とする請求項9記載の弾性表面波デバイス。

【請求項12】 前記電気シールドは接地電位とされた面状配線であることを特徴とする請求項2又は6記載の弾性表面波デバイス。

【請求項13】 前記バンプと前記基板配線とが導電性樹脂を介して接続されていることを特徴とする請求項1から12の何れか1項に記載の弾性表面波デバイス。

【請求項14】 前記バンプと前記基板配線とが異方性導電樹脂を介して接続されていることを特徴とする請求項1から12の何れか1項に記載の弾性表面波デバイス。

【請求項15】 前記第1の基板は曲げ弾性率が2~8GPaである材料を 用いて形成されていることを特徴とする請求項1から15の何れか1項に記載の 弾性表面波デバイス。

【請求項16】 前記第1の基板はビスマレイミドドリアジンレジン、ポリフェニレンエーテル又はポリイミド樹脂の少なくとも1つを含んで形成されていることを特徴とする請求項1から15の何れか1項に記載の弾性表面波デバイス。

【請求項17】 圧電基板上に形成された弾性表面波フィルタ素子がパッケージ内部に収納された弾性表面波デバイスを製造する製造方法において、

100μm以下の厚みを有する第1の基板上に前記弾性表面波フィルタ素子をフェイスダウン状態で固定する第1の工程と、

中央部に前記弾性表面波フィルタ素子を収納するためのキャビティを形成するための第2の基板と、前記キャビティに蓋をするための第3の基板とを前記第1の基板上に逐次積み重ね、前記第1から第3の基板を加圧・加熱プレスすることで相互に接着する第2の工程と

を有することを特徴とする弾性表面波デバイスの製造方法。

【請求項18】 圧電基板上に形成された弾性表面波フィルタ素子がパッケージ内部に収納された弾性表面波デバイスを製造する製造方法において、

100μm以下の厚みを有する第1の基板上に前記弾性表面波フィルタ素子をフェイスダウン状態で固定する第1の工程と、

中央部に前記弾性表面波フィルタ素子を収納するための第1のキャビティを形成するための第2の基板と、前記第1のキャビティに蓋をするための第3の基板とを前記第1の基板上に逐次積み重ね、且つ、少なくとも前記弾性表面波フィルタ素子直下の領域に第2のキャビティを形成するための第4の基板を第1の基板下に配設し、前記第1から第4の基板を加圧・加熱プレスすることで相互に接着する第2の工程と

を有することを特徴とする弾性表面波デバイスの製造方法。

【請求項19】 前記第2及び第3の基板は予め接着されていることを特徴とする請求項17又は18記載の弾性表面波デバイスの製造方法。

【請求項20】 圧電基板上に形成された弾性表面波フィルタ素子がパッケージ内部に収納された弾性表面波デバイスを製造する製造方法において、

少なくとも前記弾性表面波フィルタ素子を収納するキャビティの底面が100 μm以下の厚みであって該キャビティの側壁が収納時の該弾性表面波フィルタ素 子の高さより高い第1の基板における前記キャビティの底面に前記弾性表面波フィルタ素子をフェイスダウン状態で固定する第1の工程と、

前記キャビティ上部に蓋をするための第2の基板を前記第1の基板上に積み重ね、前記第1及び第2の基板を加圧・加熱プレスすることで接着する第2の工程と

を有することを特徴とする弾性表面波デバイスの製造方法。

【請求項21】 圧電基板上に形成された弾性表面波フィルタ素子がパッケージ内部に収納された弾性表面波デバイスを製造する製造方法において、

少なくとも前記弾性表面波フィルタ素子を収納する第1のキャビティの底面が 100μm以下の厚みであって該第1のキャビティの側壁が収納時の該弾性表面 波フィルタ素子の高さより高い第1の基板における前記第1のキャビティの底面 に前記弾性表面波フィルタ素子をフェイスダウン状態で固定する第1の工程と、

前記第1のキャビティ上部に蓋をするための第2の基板を前記第1の基板上に 積み重ね、且つ、少なくとも前記弾性表面波フィルタ素子直下の領域に第2のキャビティを形成するための第3の基板を第1の基板下に配設し、前記第1から第 3の基板を加圧・加熱プレスすることで相互に接着する第2の工程と

を有することを特徴とする弾性表面波デバイスの製造方法。

【請求項22】 前記第1から第3又は第4の基板は、複数の弾性表面波デバイスを同時に作製するための多面取り状に構成されており、

前記第2の工程で作製された積層基板を個別の前記弾性表面波デバイスに分離する第3の工程を有することを特徴とする請求項17から21の何れか1項に記載の弾性表面波デバイスの製造方法。

【請求項23】 前記第3の工程は、レーザ又は回転切削刃を用いて前記弾性表面波デバイスを分離することを特徴とする請求項22記載の弾性表面波デバイスの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、例えばテレビジョン(以下、TVと略す)やビデオテープレコーダ (以下、VTRと略す)やDVD(digital Video Disk)レ コーダや携帯電話機等のフィルタ素子や発振子に用いることができる弾性表面波 デバイス及びその製造方法に関する。

#### [0002]

#### 【従来の技術】

#### [0003]

近年、これらの信号処理機器は小型化が進み、使用されるSAWデバイスなどの電子部品も小型化の要求が強くなってきている。特に、携帯電話機等の携帯用電子機器には面実装で且つ低背のSAWデバイスが要求されるようになってきた。

#### [0004]

一般的な面実装された小型サイズのSAWデバイスの構成を図1に示す。図1に示すSAWデバイス100は、配線基板121と囲い部材122と蓋部材123とを有して構成された容器の中にSAWフィルタ素子101がフェイスダウン状態でフリップチップ実装されている。配線基板121の容器内部側の面(これを表面とする)にはSAWフィルタ素子101のバンプ111と位置合わせされた基板配線31が設けられており、これとバンプ111とが電気的に接続されている。

#### [0005]

基板配線131は配線基板121内部を貫通するビア配線132を介して裏面

に配設された電気端子133と接続されている。電気端子133は、図2に示すように、はんだ143等を用いて部品実装基板141上に設けられた配線142に接続される。

[0006]

このような構成において、SAWフィルタ素子101を収納するパッケージ( 配線基板121と囲い部材122と蓋部材123とよりなる)はセラミックスを 用いて形成される場合が多い(例えば特許文献1参照)。

[0007]

【特許文献1】

特開平7-336186号公報

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

但し、プリント基板に実装する電子部品に対しては、実装基板を曲げた際にも電子部品が破壊しないように構成しなければならない。これは、図2に示すように、部品実装基板141上に部品をはんだ付け実装した状態で部品実装基板141を歪曲させることで試験される(以下、これを基板曲げ試験という)。

 $[0\ 0\ 0\ 9]$ 

携帯電話機などに搭載される800MHz~1.9GHz帯のSAWフィルタ素子のチップサイズは一般的に2mm角以内と小さいため、この基板曲げ試験によるパッケージの変形はほとんど無視でき、十分な信頼性を確保することができる。しかしながら、例えばTV用中間周波帯フィルタとして使用される30MHz~75MHz帯の場合にはSAWフィルタ素子のチップサイズが10mm×2mm程度の大きな値となり、基板曲げ試験を行った場合のパッケージの変形は非常に大きくなる。このため、バンプを用いてパッケージとチップとを接続する接続部分に大きな応力が発生して接続が破断してしまい、SAWデバイスの実装信頼性を確保することができないという問題を発生する。

[0010]

本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、曲げに対して十分な耐久 性を有する弾性表面波デバイス及びその製造方法を提供することを目的とする。



#### 【課題を解決するための手段】

かかる目的を達成するために、本発明は、請求項1記載のように、圧電基板上に形成された弾性表面波フィルタ素子と、前記弾性表面波フィルタ素子を収納するパッケージとを有する弾性表面波デバイスにおいて、前記弾性表面波フィルタ素子が電気信号を入出力するためのバンプを有し、前記パッケージが前記弾性表面波フィルタ素子が搭載される第1の基板を有し、前記第1の基板が前記バンプを介して前記弾性表面波フィルタ素子と電気的に接続するための基板配線を有し、前記第1の基板が100 $\mu$ m以下の厚みを有して構成される。弾性表面波フィルタ素子が搭載される第1の基板の厚みを100 $\mu$ mとすることで、パッケージの変形による第1の基板の変形が生じた場合にもSAWフィルタ素子の搭載領域に生じる応力が低減される。これにより、弾性表面波デバイスを搭載する基板に曲げが生じた場合でも、弾性表面波フィルタ素子の接続部分が第1の基板から剥離されることがなく、十分な耐久性を有する弾性表面波デバイスが実現できる。

#### [0012]

また、請求項1記載の前記弾性表面波デバイスは、好ましくは請求項2記載のように、前記パッケージにおける前記弾性表面波フィルタ素子を収納するキャビティの内壁であって該弾性表面波フィルタ素子の前記バンプ形成面と反対側に対応する面に電気シールドを有するように構成される。これにより、弾性表面波フィルタ素子の動作が安定化され、良好なフィルタ特性を実現することが可能となる。

#### $[0\ 0\ 1\ 3]$

また、請求項1又は2記載の前記弾性表面波デバイスは、例えば請求項3記載のように、前記第1の基板の裏面に前記弾性表面波フィルタ素子へ電気的に接続された電気端子を有し、前記電気端子が前記パッケージの長辺に沿って配設されているように構成することも可能である。

#### [0014]

また、請求項1又は2記載の前記弾性表面波デバイスは、例えば請求項4記載のように、前記第1の基板の裏面に前記弾性表面波フィルタ素子へ電気的に接続

された電気端子を有し、前記電気端子が前記パッケージの短辺に沿って配設されているように構成することも可能である。

#### [0015]

また、請求項1又は2記載の前記弾性表面波デバイスは、例えば請求項5記載のように、前記第1の基板における前記弾性表面波フィルタ素子と反対側の面に第2の基板を有し、前記第2の基板が、少なくとも前記弾性表面波フィルタ素子直下の領域に空隙を有するように構成することも可能である。

#### [0016]

また、請求項5記載の前記弾性表面波デバイスは、好ましくは請求項6記載のように、前記第1の基板における前記弾性表面波フィルタ素子と反対側の面であって前記空隙内部に電気シールドを有するように構成される。これにより、弾性表面波フィルタ素子の動作が安定化され、より良好なフィルタ特性を実現することが可能となる。

#### $[0\ 0\ 1\ 7]$

また、請求項5又は6記載の前記弾性表面波デバイスは、例えば請求項7記載のように、前記第2の基板の裏面に前記弾性表面波フィルタ素子へ電気的に接続された電気端子を有し、前記電気端子が前記パッケージの長辺に沿って配設されているように構成することも可能である。

#### $[0\ 0\ 1\ 8]$

また、請求項5又は6記載の前記弾性表面波デバイスは、例えば請求項8記載のように、前記第2の基板の裏面に前記弾性表面波フィルタ素子へ電気的に接続された電気端子を有し、前記電気端子が前記パッケージの短辺に沿って配設されているように構成することも可能である。

#### [0019]

また、請求項5又は6記載の前記弾性表面波デバイスは、好ましくは請求項9 記載のように、前記第2の基板における前記第1の基板と反対側の面に第3の基 板を有するように構成される。第1の基板裏面に形成されたキャビティに対して 第3の基板で蓋をすることで、外部からの衝撃に対して第1の基板を保護するこ とが可能となる。

#### [0020]

また、請求項9記載の前記弾性表面波デバイスは、例えば請求項10記載のように、前記第3の基板の裏面に前記弾性表面波フィルタ素子へ電気的に接続された電気端子を有し、前記電気端子が前記パッケージの長辺に沿って配設されているように構成することも可能である。

#### [0021]

また、請求項9記載の前記弾性表面波デバイスは、例えば請求項11記載のように、前記第3の基板の裏面に前記弾性表面波フィルタ素子へ電気的に接続された電気端子を有し、前記電気端子が前記パッケージの短辺に沿って配設されているように構成することも可能である。

#### $[0\ 0\ 2\ 2]$

また、請求項2又は6記載の前記弾性表面波デバイスは、例えば請求項12記載のように、前記電気シールドを接地電位とされた面状配線で構成することも可能である。

#### [0023]

また、請求項1から12の何れか1項に記載の前記弾性表面波デバイスは、例 えば請求項13記載のように、前記バンプと前記基板配線とが導電性樹脂を介し て接続されているように構成することも可能である。

#### [0024]

また、請求項1から12の何れか1項に記載の前記弾性表面波デバイスは、例 えば請求項14記載のように、前記バンプと前記基板配線とが異方性導電樹脂を 介して接続されているように構成することも可能である。

#### [0025]

また、請求項1から15の何れか1項に記載の前記第1の基板は、好ましくは 請求項15記載のように、曲げ弾性率が2~8GPaである材料を用いて形成さ れる。従来用いられていたアルミナセラミクスと比較して十分に小さい曲げ弾性 率の材料を用いることで、第1の基板のフレキシブル性を向上できる。

#### [0026]

また、請求項1から15の何れか1項に記載の前記第1の基板は、好ましくは



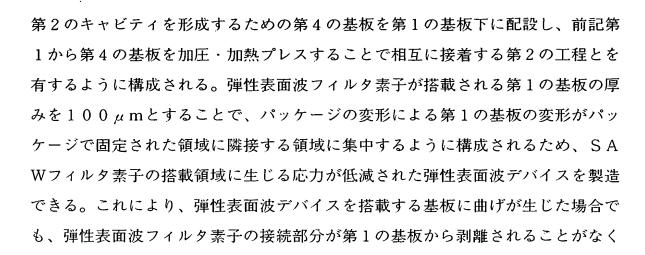
請求項16記載のように、ビスマレイミドドリアジンレジン、ポリフェニレンエーテル又はポリイミド樹脂の少なくとも1つを含んで形成されるとよい。このように、曲げ弾性率が小さい樹脂を用いることで、第1の基板のフレキシブル性を向上できるだけでなく、製法上の制限や割れに対する耐久性を向上させることができるため、より基板を薄くすることが可能となり、結果としてフレキシブル性を向上させることが可能となる。

#### [0027]

また、本発明は、請求項17記載のように、圧電基板上に形成された弾性表面 波フィルタ素子がパッケージ内部に収納された弾性表面波デバイスを製造する製造方法において、100μm以下の厚みを有する第1の基板上に前記弾性表面波フィルタ素子をフェイスダウン状態で固定する第1の工程と、中央部に前記弾性表面波フィルタ素子を収納するためのキャビティを形成するための第2の基板と、前記キャビティに蓋をするための第3の基板とを前記第1の基板上に逐次積み重ね、前記第1から第3の基板を加圧・加熱プレスすることで相互に接着する第2の工程とを有するように構成される。弾性表面波フィルタ素子が搭載される第1の基板の厚みを100μmとすることで、パッケージの変形による第1の基板の変形がパッケージで固定された領域に隣接する領域に集中するように構成されるため、SAWフィルタ素子の搭載領域に生じる応力が低減された弾性表面波デバイスを製造できる。これにより、弾性表面波デバイスを搭載する基板に曲げが生じた場合でも、弾性表面波フィルタ素子の接続部分が第1の基板から剥離されることがなく、十分な耐久性を有する弾性表面波デバイスが実現できる。

#### [0028]

また、本発明は、請求項18記載のように、圧電基板上に形成された弾性表面 波フィルタ素子がパッケージ内部に収納された弾性表面波デバイスを製造する製造方法において、100μm以下の厚みを有する第1の基板上に前記弾性表面波フィルタ素子をフェイスダウン状態で固定する第1の工程と、中央部に前記弾性表面波フィルタ素子を収納するための第1のキャビティを形成するための第2の基板と、前記第1のキャビティに蓋をするための第3の基板とを前記第1の基板上に逐次積み重ね、且つ、少なくとも前記弾性表面波フィルタ素子直下の領域に



#### [0029]

また、請求項17又は18記載の前記弾性表面波デバイスの製造方法は、好ましくは請求項19記載のように、前記第2及び第3の基板を予め接着しておくとよい。これにより、第2の工程を簡素化することができる。

、十分な耐久性を有する弾性表面波デバイスが実現できる。

#### [0030]

また、本発明は、請求項20記載のように、圧電基板上に形成された弾性表面 波フィルタ素子がパッケージ内部に収納された弾性表面波デバイスを製造する製造方法において、少なくとも前記弾性表面波フィルタ素子を収納するキャビティの底面が100μm以下の厚みであって該キャビティの側壁が収納時の該弾性表面波フィルタ素子の高さより高い第1の基板における前記キャビティの底面に前記弾性表面波フィルタ素子をフェイスダウン状態で固定する第1の工程と、前記キャビティ上部に蓋をするための第2の基板を前記第1の基板上に積み重ね、前記第1及び第2の基板を加圧・加熱プレスすることで接着する第2の工程とを有するように構成される。弾性表面波フィルタ素子が搭載される第1の基板の厚みを100μmとすることで、パッケージの変形による第1の基板の変形がパッケージで固定された領域に隣接する領域に集中するように構成されるため、SAWフィルタ素子の搭載領域に生じる応力が低減された弾性表面波デバイスを製造できる。これにより、弾性表面波デバイスを搭載する基板に曲げが生じた場合でも、弾性表面波フィルタ素子の接続部分が第1の基板から剥離されることがなく、十分な耐久性を有する弾性表面波デバイスが実現できる。また、予め第1の基板



にキャビティを形成するための側壁を設けておくことで、第1の基板の強度が高められるため、搬送時等における破損等を防止することが可能となる。

#### [0031]

また、本発明は、請求項21記載のように、圧電基板上に形成された弾性表面 波フィルタ素子がパッケージ内部に収納された弾性表面波デバイスを製造する製 造方法において、少なくとも前記弾性表面波フィルタ素子を収納する第1のキャ ビティの底面が100μm以下の厚みであって該第1のキャビティの側壁が収納 時の該弾性表面波フィルタ素子の高さより高い第1の基板における前記第1のキ ャビティの底面に前記弾性表面波フィルタ素子をフェイスダウン状態で固定する 第1の工程と、前記第1のキャビティ上部に蓋をするための第2の基板を前記第 1の基板上に積み重ね、且つ、少なくとも前記弾性表面波フィルタ素子直下の領 域に第2のキャビティを形成するための第3の基板を第1の基板下に配設し、前 記第1から第3の基板を加圧・加熱プレスすることで相互に接着する第2の工程 とを有するように構成される。弾性表面波フィルタ素子が搭載される第1の基板 の厚みを100μmとすることで、パッケージの変形による第1の基板の変形が パッケージで固定された領域に隣接する領域に集中するように構成されるため、 SAWフィルタ素子の搭載領域に生じる応力が低減された弾性表面波デバイスを 製造できる。これにより、弾性表面波デバイスを搭載する基板に曲げが生じた場 合でも、弾性表面波フィルタ素子の接続部分が第1の基板から剥離されることが なく、十分な耐久性を有する弾性表面波デバイスが実現できる。また、予め第1 の基板にキャビティを形成するための側壁を設けておくことで、第1の基板の強 度が高められるため、搬送時等における破損等を防止することが可能となる。

#### [0032]

また、請求項17から21の何れか1項に記載の前記弾性表面波デバイスの製造方法は、好ましくは請求項22記載のように、前記第1から第3又は第4の基板が、複数の弾性表面波デバイスを同時に作製するための多面取り状に構成されており、前記第2の工程で作製された積層基板を個別の前記弾性表面波デバイスに分離する第3の工程を有するように構成するとよい。これにより一度に複数の弾性表面波デバイスを製造することが可能となり、製造効率が向上される。



また、請求項22記載の前記第3の工程は、例えば請求項23記載のように、 レーザ又は回転切削刃を用いて前記弾性表面波デバイスを分離するように構成し てもよい。

#### [0034]

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の好適な実施形態について図面を用いて詳細に説明する。

#### [0035]

#### [第1の実施形態]

まず、本発明の第1の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。図3(a)は、本実施形態で用いるSAWフィルタ素子1の構成を示す上面図であり、(b)はSAWデバイス10の構成を示すA-A断面図であり、(c)はSAWデバイス10の構成を示すB-B断面図であり、(d)はSAWデバイス10の構成を示す下面図である。但し、本実施形態では、TV中間周波数帯で使用されるSAWフィルタ素子1を用いた場合を例に挙げて説明する。

#### [0036]

図3(a)に示すように、SAWフィルタ素子1は、圧電基板12上に櫛形電極(InterDigital Transducer:IDT)13と電極端子がパターニング形成され、電極端子の上部に金属製(好ましくは金(Au)製)のバンプ11が形成された構成を有している。尚、このSAWフィルタ素子1には、弾性表面波(Surface Acoustic Wave)の反射を低減するために櫛形電極13を覆うように吸音材14が印刷形成されている。また、SAWの伝播方向における圧電基板12の端面での反射によるフィルタ特性の悪化を防止するために、この端面がSAW伝播方向に対して所定の角度を有するように形成されている場合がある。更に、櫛形電極13は、所望するフィルタ特性を考慮して、その電極指周期や重み付け形状が制御されて設計されている。

#### [0037]

このSAWフィルタ素子1は、図3(b)に示すように、フレキシブルプリント基板(以下、FPCと略す)21と樹脂基板22及び23と配線樹脂基板25

とよりなる4層構造(多層構造)のパッケージにフェイスダウン状態にフリップチップ実装されて固定されている。即ち、FPC21の第1面(これを表面とする)上にSAWフィルタ素子1を収納可能なキャビティ20を形成するために中央部に開口を有する枠状に形成された樹脂基板22がFPC21の表面に着設され、これにより形成されたキャビティ20内にSAWフィルタ素子1を実装した後、FPC21及び樹脂基板22と共にキャビティ20に蓋をして密閉するように樹脂基板23を着設する。この際、バンプ11とFPC21との電気的及び機械的な接続には、導電性樹脂51を用いるとよい。このように、比較的柔軟性の高い(はんだ等に比べて)導電接着材料を用いることで、FPC21から受ける応力を低減することが可能となる。

#### [0038]

また、FPC21の裏面には、FPC21の所望の変形が邪魔されないためのキャビティ30を形成するために中央部に開口を有する枠状に形成された配線樹脂基板25が着設される。尚、樹脂基板22,23及び配線樹脂基板25には一般的に価格の安いガラスエポキシを用いることが好ましいが、BT(ビスマレイミドドリアジン)レジンやPPE(ポリフェニレンエーテル)やポリイミド樹脂等を用いることも可能である。

#### [0039]

この構成において、FPC21は他の基板(22,23,25)の変形により受けた変形がSAWフィルタ素子1の実装領域に影響しない程度の柔軟さを有して形成されている。即ち、他の基板が変形することで受けた変形が他の基板で挟持された部分の近傍のみに集中し、SAWフィルタ素子1の実装領域がバンプ接続に不具合を生じさせるほどに変形しないことが達成される程度のフレキシブル性を有するように形成される。

#### [0040]

このようなフレキシブル性を達成する1つの要素として、本実施形態では、FPC21を例えばBTレジンやポリイミド樹脂やPPE等の比較的(従来SAWフィルタ素子1を搭載する基板に使われていたアルミナセラミクスと比較して)曲げ弾性率Eの小さい絶縁材料を用いる。ここで、曲げ弾性率Eの定義を図4を

用いて詳細に説明する。

#### [0041]

図4に示すように、長辺の長さL,短辺の長さ(幅)b,厚みhの基板(本実施形態ではFPC21に対応)に対して上方から上面の中心に垂直方向に力Fを加えた場合、曲げに対する応力(以下、曲げ応力という) $\sigma$ は以下の式1で表される。また、この際の変形量をSとすると、曲げに対するひずみ(以下、曲げひずみという) $\varepsilon$  は以下の式2で表される。

【数1】

$$\sigma = \frac{3FL}{2bh^2} \qquad \cdots (\vec{\pm} 1)$$

【数2】

$$\varepsilon = \frac{6\text{Sh}}{1^2} \quad \cdots (\pm 2)$$

[0042]

曲げ弾性率Eは、曲げ応力 $\sigma$ を曲げひずみ $\varepsilon$ で除算して求まる値である。従って、曲げ弾性率Eは、以下の式3で定義される。尚、各長さの単位は [mm]であり、曲げ弾性率Eの単位は [MPa]である。

【数3】

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{3FL}{2bh^2} \cdot \frac{L^2}{6Sh} = \frac{FL^3}{4Sbh^3} \qquad \cdots (\vec{\pi}3)$$

[0043]

例として、 $E_0=2\sim 8$  G P a の材料(B T レジンやポリイミド樹脂や P P E 等の曲げ弾性率 E に相当)を用いて L=1 0 mm, h=0. 1 mm(1 0 0  $\mu$  m), b=2 mmの寸法で構成した基板の変形量 S が 0. 0 1 mm(1 0  $\mu$  m)であったとすると、加えた力 F は 1.  $6\sim 6$ .  $4\times 10^{-4}$  [N] (1.  $6\sim 6$ . 4

 $\times$ 10<sup>-2</sup> [gf])と求められる。これは、従来SAWフィルタ素子1を搭載する基板に使われていたアルミナセラミクス(曲げ弾性率 $E_1$ =314GPa)に対して同じ変形量Sを得るために必要な力F=2.5 $\times$ 10<sup>-2</sup> [N](2.5 [gf])と比較して、100分の1程度の大きさである。従って、本実施形態のように、曲げ弾性率Eが2 $\sim$ 8GPa程度の材料を用いることで、非常にフレキシブルなFPC21を形成することができる。尚、従来、アルミナセラミクスを用いた場合、製法上の制限や割れに対する耐久性を向上させるために、基板厚を約200 $\mu$ m以上とする必要がある。これに対し、本実施形態のように、BTレジンやポリイミド樹脂やPPE等の樹脂を用いた場合、より薄い基板を形成することができる。このような観点からも、本実施形態が非常に大きなメリットを得られることがわかる。

#### [0044]

そこで、本実施形態では、FPC21をバンプ接続に不具合が発生するのを確実に防止するために、厚さを $100\mu$ m以下で構成する。これにより、パッケージの曲げに対してSAWフィルタ素子1の実装領域に生じる応力が十分に抑えられる。また、より好ましくはFPC21の厚さを $80\mu$ m以下とすることで、FPC21の材料がどのようなものであっても、パッケージの曲げに対してSAWフィルタ素子1の実装領域にバンプ接続に不具合を生じさせるほどの応力が発生することを防止することができる。

#### [0045]

尚、本実施形態の寸法例を示すと、SAWデバイス10のパッケージは、長辺の長さが10.8mm,短辺の長さが3.8mm,厚みが600 $\mu$ mである。FPC21の厚みは50 $\mu$ mである。また、パッケージ内部のキャビティ20の寸法は、長辺の長さが9.2mm,短辺の長さが2.2mm,高さが0.5mmである。

#### [0046]

また、FPC21表面に配設された基板配線31は、図3(c)に示すように 、FPC21及び配線樹脂基板25を貫通するように設けられたビアに嵌設され たビア配線23を介して配線樹脂基板25裏面に配設された電気端子33に接続 されている。

#### [0047]

尚、電子端子33は、図3(d)に示すように、配線樹脂基板25裏面における両長辺の中央付近に密集するように配設されている。この寸法は、例えば個々の電気端子33の中心間の距離が1.27mmとなるように構成する。これにより、SAWデバイス10の電気特性が改善されるだけでなく、部品実装基板41(図5参照)の変形によりSAWデバイス10が変形することを抑制できる。

#### [0048]

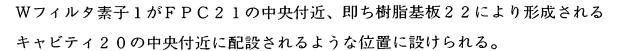
以上のように、1パッケージとして構成されたSAWデバイス10は、例えば 図5に示すように、部品実装基板41上に配設された基板配線42と電気端子3 3とがはんだ43により固着されることで実装される。尚、このようにSAWデバイス10を部品実装基板41上にはんだ実装する場合、はんだリフローによる 熱加工を経るため、SAWフィルタ素子1上に形成されたバンプ11にはAuバンプを用いることが好ましい。

#### [0049]

この部品実装基板41に対して基板曲げ試験を行った際のSAWデバイス10が受ける歪みの様子を図5は示している。図5を参照すると明らかなように、部品実装基板41が曲がると、その影響を受け、SAWデバイス10のはんだ接続部の枠状の配線樹脂基板25が変形する。しかしながら、SAWデバイス10が搭載されているFPC21は、十分に柔らかいため、FPC21が変形してもSAWフィルタ素子1のバンプ11との接続部分にはほとんど応力がかからない。このため、基板曲げ試験に対して十分な信頼性を保証することができる。尚、SAWフィルタ素子1のバンプ11とFPC21との接続部分に発生する変形応力を、極力少なくするために、樹脂基板22及び配線樹脂基板25の内枠がバンプ11の接続領域よりも外側となるように制限する

#### [0050]

次に、図6を用いて、上述したSAWデバイス10の製造プロセスを説明する。本製造プロセスでは、まず、図6 (a) に示すように、基板配線31が配設された厚さ50μm程度のFPC21を作製する。この際、基板配線31は、SA



#### [0051]

次に、図6(b)に示すように、上記の基板配線31上であってSAWフィルタ素子1のバンプ11が配設される位置に導電性樹脂51をスクリーン印刷によりパターン形成し、これにSAWフィルタ素子1をフェイスダウン状態でフリップチップ接続して固定する(図6(c)参照)。

#### [0052]

その後、FPC21の裏面に対してビア配線32及び電気端子33(図3(c)参照)が形成された配線樹脂基板25を、また、FPC21の表面に対してキャビティ20を形成するための樹脂基板22及びこのキャビティ20に蓋をするための樹脂基板23を、それぞれ積み重ね、これらを加圧・加熱プレスすることにより相互に接着する。これにより、SAWデバイス10が作製される。但し、樹脂基板22及び23を予め接着しておくことで、図6(d)における工程を簡素化してもよい。

#### [0053]

尚、図6を用いた説明では、1個のSAWデバイス10を作製する際の製造プロセスについて例示したが、実際にはFPC21と樹脂基板22及び23と配線樹脂基板25とを2次元的に複数個配置した多面取り構造の基板を一度に貼り合わせ、最後にレーザ等により個々のSAWデバイス10に切断する工程とすることにより、より低コストでSAWデバイス10を製造することが可能となる。また、切断に関しては回転切削刃や押し切り刃を用いて行いてもよい。

#### [0054]

上記したSAWデバイス10の他の製造プロセスを図7を用いて説明する。本製造プロセスでは、図7(a)に示すように、SAWフィルタ素子1のFPC21への搭載より先に、FPC21表面に樹脂基板22を用いてキャビティ20を形成しておく。このようにFPC21に樹脂基板22を前もって着設しておくことで、基板強度が確保されるため、これを搬送し易くなる。

#### [0055]



但し、このように先に樹脂基板22を着設した場合、SAWフィルタ素子1をFPC21に接続して固定するための導電性樹脂51をFPC21の基板配線31上にスクリーン印刷することが困難となる。そこで、本製造プロセスでは、図7(b)に示すように、FPC21の表面上であってキャビティ20内部に異方性導電シート52を落とし込み、この上からSAWフィルタ素子1を接着固定する(図7(c)参照)。

#### [0056]

その後、FPC21の裏面に対してビア配線32及び電気端子33が形成された配線樹脂基板25を、また、FPC21の表面であってキャビティ20を形成するための樹脂基板22及びこのキャビティ20に蓋をするための樹脂基板23を、それぞれ積み重ね、これらを加圧・加熱プレスすることにより相互に接着する。これにより、SAWデバイス10が作製される。尚、他の構成は、図6で説明した製造プロセスと同様であるため、ここでは説明を省略する。

#### [0057]

以上のように、SAWフィルタ素子を搭載する基板部(FPC21)に十分な 柔軟性をもたせることで、SAWフィルタ素子とパッケージとの接続部分に発生 する応力が低減されるため、SAWデバイスを搭載する基板が歪みを受けても、 パッケージ内部のSAWフィルタ素子の接続部分の剥離を防止することが可能と なり、SAWデバイスの実装信頼性を確保することができる。

#### [0058]

#### 〔第2の実施形態〕

次に、上述した第1の実施形態によるSAWデバイス10の他の構成例を、以下に第2の実施形態として幾つか例を挙げて説明する。

#### [0059]

図8 (a) は、本実施形態における第1の例によるSAWデバイス60の構成を示すA-A断面図である。尚、A-A断面は、第1の実施形態における図3(b)と対応するものとする。

#### [0060]

図8(a)に示すように、第1の例によるSAWデバイス60は、第1の実施

形態によるSAWデバイス10と同様の構成において、配線樹脂基板25の裏面 (FPC21と反対側) に平面状のFPC61が着設されており、キャビティ30が密閉されている。

#### $[0\ 0\ 6\ 1\ ]$

第1の実施形態によるFPC21は上述したように他の基板(22,23,25)と比較して非常に薄く、外部からの衝撃に対して破損しやすい。そこで、図8(a)のように、キャビティ30に蓋(FPC61)をしてFPC21に直接外部からの衝撃が加わらないように構成することで、FPC21の破損を防止することが可能となる。尚、第1の実施形態において配線樹脂基板25の裏面に配設されていた電気端子33はFPC61の裏面に配設されており(図3(d)と同様)、ビア配線32はFPC61をも貫通することで電気端子33と基板配線31とを電気的に接続している。また、他の構成は、第1の実施形態と同様であるため、ここでは説明を省略する。更に、その製造プロセスは、配線樹脂基板25の裏面にFPC61を積み重ね、図6(又は図7)における(d)と同様に、これらを加圧・加熱プレスして接着するように構成される。これにより、SAWデバイス60が作製される。

#### $[0\ 0\ 6\ 2]$

また、図8(b)は、本実施形態における第2の例によるSAWデバイス70の構成を示すB-B断面図である。尚、B-B断面は、第1の実施形態における図3(c)と対応するものとする。

#### [0063]

図8(b)に示すように、本実施形態によるSAWデバイス70は、第1の実施形態によるSAWデバイス10と同様の構成において、樹脂基板23の裏面(キャビティ20側)全体に面状の配線(面配線75)を有するように構成されている。尚、この面配線75は、樹脂基板22を貫通するように嵌設されたビア配線74を介して基板配線31及びこれと接続された電気端子33に電気的に接続されている。

#### [0064]

この面配線75は、SAWフィルタ素子1に入射するノイズを低減させる電気



シールドとして機能する。従って、SAWフィルタ素子1を収納するキャビティ20の上部に接地電位の面配線75を形成する、換言すれば、キャビティ20の内壁であって弾性表面波フィルタ素子1の上部に電気シールドを形成することで、SAWフィルタ素子1を電気的に保護することが可能となり、SAWフィルタ素子1の動作を安定化させることが可能となる。尚、他の構成は、第1の実施形態と同様であるため、ここでは説明を省略する。更に、その製造プロセスは、樹脂基板23の裏面に予め面配線75をメタライズ形成しておき、これを図6(又は図7)における(d)と同様に加圧・加熱プレスして接着するように構成される。これにより、SAWデバイス70が作製される。

#### [0065]

また、図8 (c) は、第2の例によるSAWデバイス70におけるSAWフィルタ素子1を下側からも電気的に保護するように構成した例(これを第3の例とする)を示している。尚、図8 (c) は (b) と同様にB-B断面を示す。

#### [0066]

以上のように、SAWフィルタ素子1を下側から電気的に保護するために、本例ではキャビティ30の上部、即ちFPC21の裏面全体に面状の配線(面配線82)を形成している。尚、この面配線82は、PFC21を貫通するように嵌設されたビア配線81を介して配線基板31と接続されており、また、配線樹脂基板25を貫通するように嵌設されたビア配線32を介して電気端子33と接続されている。

#### [0067]

この面配線 7 5 は、SAWフィルタ素子1に入射するノイズを低減させる電気シールドとして機能する。従って、SAWフィルタ素子1を収納するキャビティ20の下部に接地電位の面配線 7 5 を形成する、換言すれば、FPC21における弾性表面波フィルタ素子1の反対側の面であってキャビティ30内部に電気シールドを形成することで、SAWフィルタ素子1を電気的により保護することが可能となり、SAWフィルタ素子1の動作を安定化させることが可能となる。尚、他の構成は、第1の実施形態と同様であるため、ここでは説明を省略する。また、その製造プロセスは、樹脂基板23の裏面に予め面配線75をメタライズ形

成しておき、且つ、FPC21の裏面に予め面配線82をメタライズ形成して両面配線基板としておき、これらを図6(又は図7)における(d)と同様に加圧・加熱プレスして接着するように構成される。これにより、SAWデバイス80が作製される。

#### [0068]

#### [第3の実施形態]

次に、本発明の第3の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。上記した第1の実施形態では、SAWフィルタ素子1が設置されるFPC21の裏面にキャビティ30を形成するための配線樹脂基板25を設けていた。ここで、電気端子33をはんだリフローにより部品実装基板41へ実装する場合、はんだ自体が下駄として機能し、SAWデバイス10が浮いた状態となる。以下では、このような構成を利用して、配線樹脂基板25fを省略した場合について第3の実施形態として図面を用いて詳細に説明する。

#### [0069]

図9は、本実施形態によるSAWデバイス90の構成を示す図であり、(a)はそのA-A断面図であり、(b)はそのB-B断面図であり、(c)はその下面図である。

#### [0070]

図9(a)に示すように、SAWフィルタ素子1は、FPC21と樹脂基板22及び23とよりなる3層のパッケージにフェイスダウン状態にフリップチップ 実装される。この構成は第1の実施形態と同様である。

#### [0071]

また、本実施形態においてFPC21の裏面には、電気端子33が配設されており、これらがFPC21を貫通して嵌設されたビア配線92を介してFPC21表面に配設された基板配線31と電気的に接続されている(図9(b)及び(c)参照)。

#### [0072]

このように1パッケージとして構成されたSAWデバイス90は、例えば図10に示すように、部品実装基板41上に配設された基板配線42と電気端子33

とがはんだ43により固着されることで実装される。

#### [0073]

そこで、部品実装基板41に対して基板曲げ試験を行った場合、図10に示すように、部品実装基板41が曲がると、その影響を受け、SAWデバイス90のはんだ接続部のFPC21及びこれに固着された樹脂基板22が変形する。しかしながら、SAWデバイス90が搭載されているFPC21は、第1の実施形態と同様に十分柔らかいため、FPC21が変形してもSAWフィルタ素子1のバンプ11との接続部分にはほとんど応力がかからない。このため、基板曲げ試験に対して十分な信頼性を保証することができる。尚、SAWフィルタ素子1のバンプ11とFPC21との接続部分に発生する変形応力を、極力少なくするために、樹脂基板22の内枠がバンプ11の接続領域よりも外側となるように制限する。また、他の構成は、第1の実施形態と同様であるため、ここでは説明を省略する。

#### [0074]

次に、図11を用いて、上述したSAWデバイス90の製造プロセスを説明する。本製造プロセスでは、まず、図11(a)に示すように、基板配線31及び電気端子33が配設された厚さ50 $\mu$  m程度の両面配線基板であるFPC21を作製し、これに予め樹脂基板22を着設しておく。この着設は、FPC21の表面に樹脂基板22を重ね、これらを加圧・加熱プレスすること行われる。尚、基板配線31は、SAWフィルタ素子1がFPC21の中央付近、即ち樹脂基板22により形成されるキャビティ20の中央付近に配設されるような位置に設けられる。

#### [0075]

次に、図11(b)に示すように、上記のプロセスで形成されたキャビティ20内部のFPC21表面上に異方性導電シート52を落とし込み、この上からSAWフィルタ素子1を着設固定する(図11(c)参照)。尚、ここまでのプロセスは、図7(a)~(c)と同様である。

#### [0076]

このようにSAWフィルタ素子1を搭載した後、裏面に接着シート91が添付

された樹脂基板23を樹脂基板22上から被せ、キャビティ20に蓋をする。以上のようなプロセスを経ることで、本実施形態によるSAWデバイス90が作製される。尚、他の構成は第1の実施形態(特に図7)と同様であるため、ここでは説明を省略する。また、ここでは第1の実施形態における図7に示した製造プロセスを引用して説明したが、本実施形態ではこれに限定されず、例えば図6に示した製造プロセスに基づいて製造することも可能である。

#### [0077]

#### 〔第4の実施形態〕

次に、本発明の第4の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。上記した第3の実施形態では、部品実装基板41と電気的な接続を形成するための電気端子33を、SAWデバイス90の裏面における長辺に沿って配列していた。但し、電気端子33をSAWデバイス90の短辺に沿って配列させてもよい。本実施形態では、このように構成した場合について例を挙げて説明する。

#### [0078]

図12は、本実施形態によるSAWデバイス95の構成を示す図であり、(a)はそのA-A断面図であり、(b)はそのB-B断面図であり、(c)はその下面図である。

#### [0079]

図12(a)から(c)に示すように、SAWデバイス95において、FPC 21裏面の電気端子33は、短辺の中央付近に密集して配設されている。また、FPC21表面に配設された基板配線31は、FPC21の外辺付近で電気端子 33とコンタクトを取るために、FPC21の短辺側へ延在している。この他の 構成は、第3の実施形態と同様であるため、ここでは説明を省略する。

#### [0080]

また、以上のように1パッケージとして構成されたSAWデバイス95を搭載した部品実装基板41に対して基板曲げ試験を行った場合を、図13に示す。図13に示すように、部品実装基板41が曲がると、その影響を受け、SAWデバイス95のはんだ接続部のFPC21及びこれに固着された樹脂基板22が変形する。そこで本実施形態では、SAWデバイス95の長辺の端がはんだ43によ

り固着されているため、SAWデバイス95の変形をFPC21がより緩衝でき、SAWフィルタ素子1の接続領域にかかる応力を更に低減することが可能となる。尚、他の構成は第1の実施形態と同様であるため、ここでは説明を省略する

#### [0081]

#### [他の実施形態]

以上、説明した実施形態は本発明の好適な一実施形態にすぎず、本発明はその 趣旨を逸脱しない限り種々変形して実施可能である。

#### [0082]

#### 【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、曲げに対して十分な耐久性を有する弾性表面波デバイス及びその製造方法が実現される。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 図1

従来技術によるSAWデバイス100の構成を示す断面図である。

#### 【図2】

SAWデバイス100が実装された部品実装基板141に対して基板曲げ試験を行った際の問題点を指摘するための断面図である。

#### 【図3】

本発明の第1の実施形態によるSAWデバイス10の構成を示す図であり、(a)はSAWフィルタ素子1の構成を示す上面図であり、(b)はSAWデバイス10の構成を示すA-A断面図であり、(c)はSAWデバイス10の構成を示すB-B断面図であり、(d)はSAWデバイス10の構成を示す下面図である。

#### 【図4】

本発明における曲げ弾性率Eの定義を説明するための図である。

#### 【図5】

SAWデバイス10が実装された部品実装基板41に対して基板曲げ試験を行った際の本発明の第1の実施形態による効果を説明するための図である。

#### 【図6】

本発明の第1の実施形態によるSAWデバイス10の製造プロセスを説明する ための図である。

#### 【図7】

本発明の第1の実施形態によるSAWデバイス10の他の製造プロセスを説明 するための図である。

#### 【図8】

本発明の第2の実施形態によるSAWデバイス60, 70及び80の構成を示す図であり、(a)はSAWデバイス60の構成を示すA-A断面図であり、(b)はSAWデバイス70の構成を示すB-B断面図であり、(d)はSAWデバイス80の構成を示すB-B断面図である。

#### 【図9】

本発明の第3の実施形態によるSAWデバイス90の構成を示す図であり、(a)はそのA-A断面図であり、(b)はそのB-B断面図であり、(c)はその下面図である。

#### 【図10】

SAWデバイス90が実装された部品実装基板41に対して基板曲げ試験を行った際の本発明の第3の実施形態による効果を説明するための図である。

#### 【図11】

本発明の第3の実施形態によるSAWデバイス90の製造プロセスを説明する ための図である。

#### 【図12】

本発明の第4の実施形態によるSAWデバイス95の構成を示す図であり、(a)はそのA-A断面図であり、(b)はそのB-B断面図であり、(c)はその下面図である。

#### 【図13】

SAWデバイス95が実装された部品実装基板41に対して基板曲げ試験を行った際の本発明の第4の実施形態による効果を説明するための図である。

#### 【符号の説明】

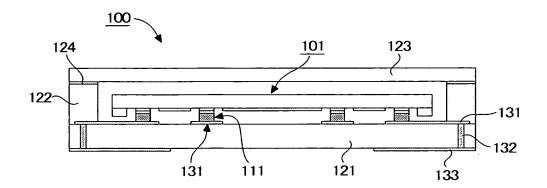
- 1 SAWフィルタ素子
- 10、60、70、80、90、95 SAWデバイス
- 11 バンプ
- 12 圧電基板
- 13 櫛形電極
- 14 吸音材
- 20、30 キャビティ
- 21,61 FPC
  - 22、23 樹脂基板
  - 25 配線樹脂基板
  - 3 1 、 4 2 基板配線
  - 32、74、81、92 ビア配線
  - 33 電気端子
  - 4 1 部品実装基板
  - 43 はんだ
  - 51 導電性樹脂
  - 52 異方性導電シート
  - 75、82 面配線
  - 91 接着シート

ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC
1050 Connecticut Avenue, N.W., Suite 400
Washington, D.C. 20036-5339
Docket No. 025720-00022
Serial No.: New Application Filed: January 27, 2004

【書類名】

【図1】

Inventor: MISHIMA

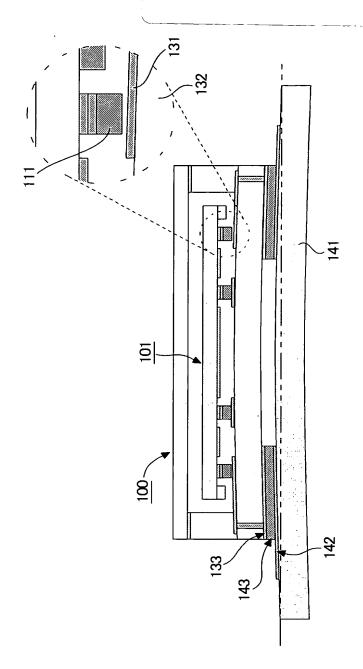


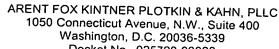
2/

# ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC 1050 Connecticut Avenue, N.W., Suite 400 Washington, D.C. 20036-5339 Docket No. 025720-00022 Serial No.: New Application Filed: January 27, 2004

Inventor: MISHIMA



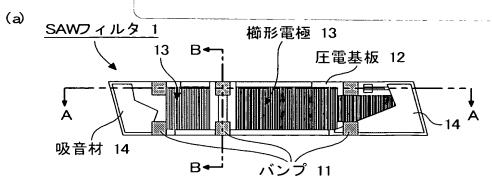


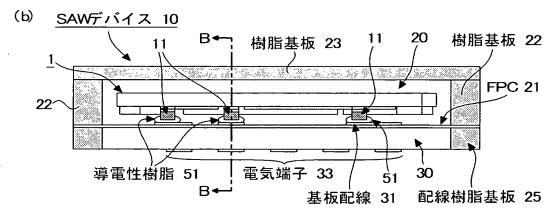


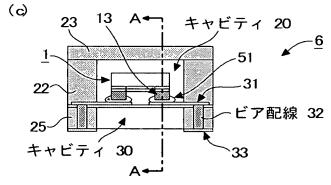
Docket No. 025720-00022

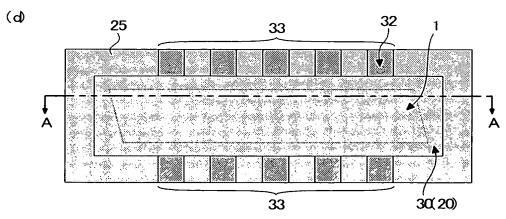


Serial No.: New Application Filed: January 27, 2004 Inventor: MISHIMA









ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC
1050 Connecticut Avenue, N.W., Suite 400
Washington, D.C. 20036-5339
Docket No. 025720-00022
Serial No.: New Application Filed: January 27, 2004

Inventor: MISHIMA

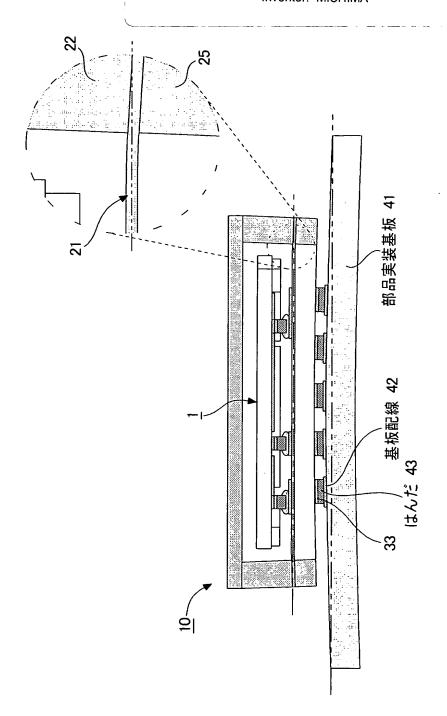
【図4】

力F 厚み h 変形量 S

5/

ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC 1050 Connecticut Avenue, N.W., Suite 400 Washington, D.C. 20036-5339 Docket No. 025720-00022 Serial No.: New Application Filed: January 27, 2004 Inventor: MISHIMA

【図5】



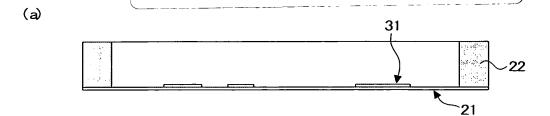
33

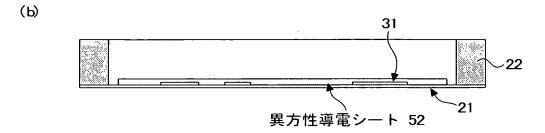
`25

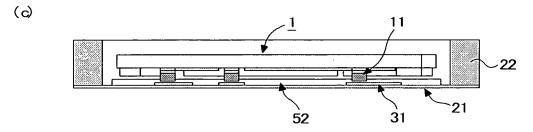
30

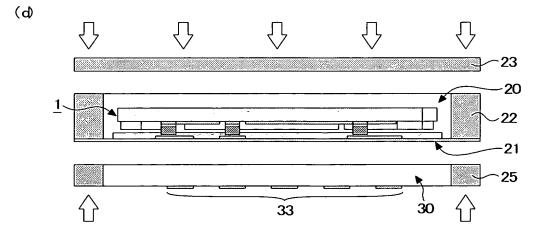
### ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC 1050 Connecticut Avenue, N.W., Suite 400 Washington, D.C. 20036-5339 Docket No. 025720-00022 Serial No.: New Application File January 27, 2004

【図7】 Inventor: MISHIMA





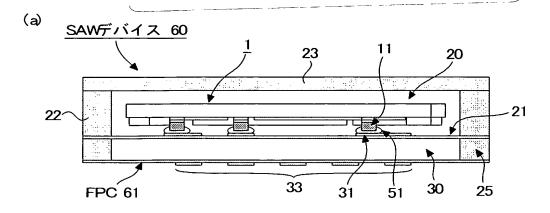


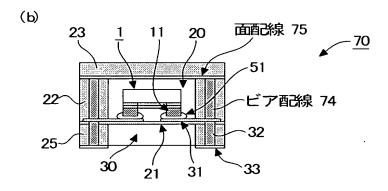


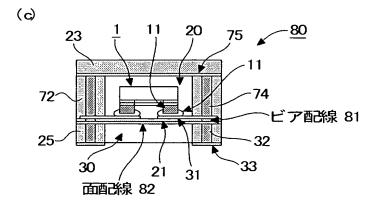
#### ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC 1050 Connecticut Avenue, N.W., Suite 400 Washington, D.C. 20036-5339 Docket No. 025720-00022 Serial No.: New Application Filed: January 27, 2004

【図8】

Inventor: MISHIMA





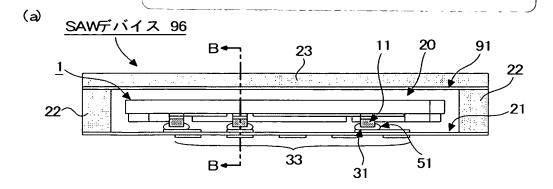


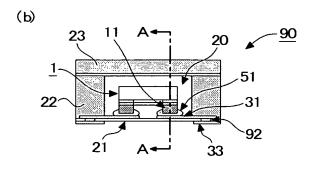
### ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC 1050 Connecticut Avenue, N.W., Suite 400 Washington, D.C. 20036-5339

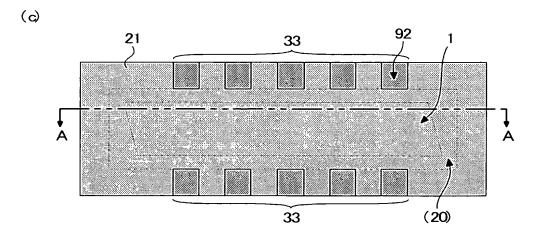
Docket No. 025720-00022

【図9】

Serial No.: New Application Filed: January 27, 2004 Inventor: MISHIMA

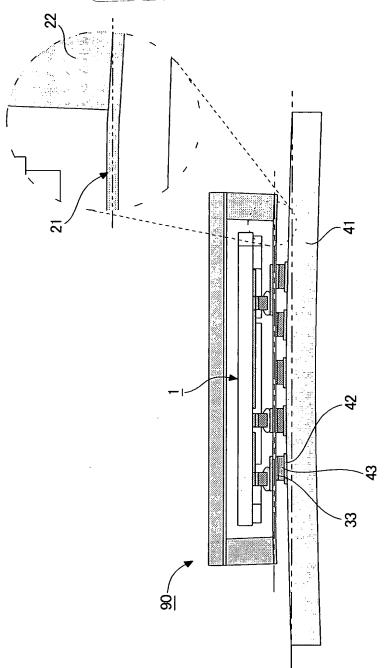






ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC 1050 Connecticut Avenue, N.W., Suite 400
Washington, D.C. 20036-5339
Docket No. 025720-00022
Serial No.: New Application Filed: January 27, 2004
Inventor: MISHIMA





33

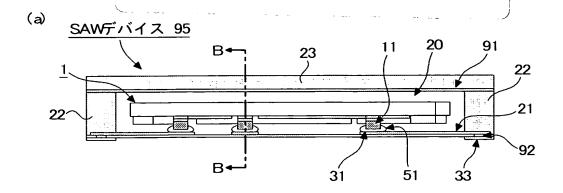
21

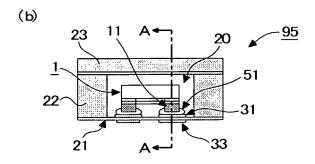
ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC 1050 Connecticut Avenue, N.W., Suite 400 Washington, D.C. 20036-5339

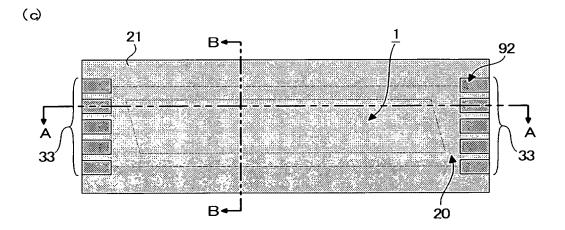
Docket No. 025720-00022

Serial No.: New Application Filed: January 27, 2004 Inventor: MISHIMA

【図12



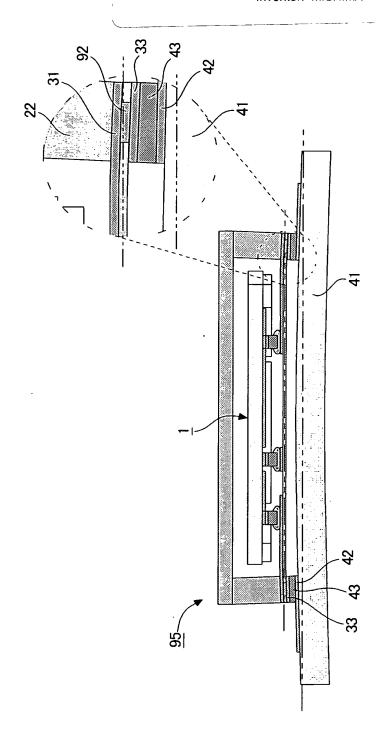




## ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC 1050 Connecticut Avenue, N.W., Suite 400 Washington, D.C. 20036-5339 Docket No. 025720-00022 Serial No.: New Application Filed: January 27, 2004

【図13】

Inventor: MISHIMA



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 曲げに対して十分な耐久性を有する弾性表面波デバイス及びその製造 方法を提供する。

【解決手段】 FPC21と樹脂基板22及び23と配線樹脂基板25とを含むパッケージにフェイスダウン状態にSAWフィルタ素子1が固定されたSAWデバイス10において、FPC21に他の基板(22,23,25)の変形により受けた変形がSAWフィルタ素子1の実装領域に影響しない程度の柔軟さをもたせる。このために、FPC21の厚みを100 $\mu$ m以下とする。尚、FPC21を形成する材料としては、例えばBTレジンやポリイミド樹脂やPPE等の比較的弾性の高い絶縁材料を用いる。

【選択図】

図 3



特願2003-018777

#### 出願人履歴情報

識別番号

[398067270]

1. 変更年月日

2002年11月 5日

[変更理由]

住所変更

住 所

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番12号

氏 名

富士通メディアデバイス株式会社

2. 変更年月日

2003年 5月30日

[変更理由]

住所変更

住 所

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番地12

氏 名

富士通メディアデバイス株式会社